

DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/JP2018/012061
International filing date:	26 March 2018 (26.03.2018)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: JP
	Number: 2017-071773
	Filing date: 31 March 2017 (31.03.2017)
Date of receipt at the International Bureau:	05 April 2018 (05.04.2018)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)

CERTIFICATE OF AVAILABILITY OF A CERTIFIED PATENT DOCUMENT IN A DIGITAL LIBRARY

The International Bureau certifies that a copy of the patent application indicated below has been available to the WIPO Digital Access Service since the date of availability indicated, and that the patent application has been available to the indicated Office(s) as of the date specified following the relevant Office code:

Document details: Country/Office: **JP**

Filing date: **31 Mar 2017 (31.03.2017)**

Application number: **2017-071773**

Date of availability of document: **03 Apr 2017 (03.04.2017)**

The following Offices can retrieve this document by using the access code:

JP, US, SE, NZ, KR, EA, IN, BR, GB, AU, ES, IB, EE, CN, MA, FI

Date of issue of this certificate: **05 Apr 2018 (05.04.2018)**

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2017年 3月31日

出 願 番 号
Application Number: 特願2017-071773

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

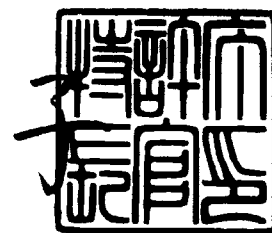
J P 2 0 1 7 - 0 7 1 7 7 3

出 願 人
Applicant(s): シャープ株式会社

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2018年 4月 5日

宗 像 直



【書類名】 特許願
【整理番号】 16J02265
【提出日】 平成29年 3月31日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G02F 1/1333
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 北川 英樹
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 今井 元
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 伊藤 俊克
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 菊池 哲郎
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 鈴木 正彦
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 上田 輝幸
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 原 健吾
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 西宮 節治
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府堺市堺区匠町 1 番地 シヤープ株式会社内
【氏名】 大東 徹
【特許出願人】
【識別番号】 000005049
【氏名又は名称】 シヤープ株式会社
【代理人】
【識別番号】 110000338
【氏名又は名称】 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT
& TRADEMARK
【代表者】 原 謙三
【電話番号】 06-6351-4384
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 277923
【納付金額】 14,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 要約書 1
【物件名】 図面 1
【包括委任状番号】 0500148

【書類名】明細書

【発明の名称】アクティブマトリクス基板、液晶表示装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、アクティブマトリクス基板に関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献1には、TFTと、画素電極と、スリットを有する共通電極とを備え、画素電極とTFTのドレイン電極とがコンタクトホールで接続されている液晶表示装置が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2010-8758号公報（2010年1月14日公開）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

高精細化のためにTFTとコンタクトホールとの距離を縮めると画素欠陥が増えるという問題がある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

行方向に隣り合う2つのサブ画素の一方に対応する第1半導体膜と、他方に対応する第2半導体膜と、前記第1半導体膜の一部を行方向のチャンネルとするトランジスタと、コンタクトホールを介して前記トランジスタのドレイン電極に接続する画素電極とを備え、平面視においては、前記チャンネルのドレイン電極側エッジから前記コンタクトホールの底面に到るまでの行方向の距離が、行方向のサブ画素ピッチの0.15倍以上である。

【発明の効果】

【0006】

画素欠陥の発生を抑えながら高精細化が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】本実施形態にかかる表示装置の構成を示すものであり、(a)は全体構成を示す断面模式図、(b)は全体構成を示す平面模式図、(c)は表示部の画素回路を示す回路図である。

【図2】実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す平面図である。

【図3】実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す断面図である。

【図4】実施形態1にかかる画素電極および共通電極の構成を示す平面図である。

【図5】実施形態1のコンタクトホールの位置を示す断面図である。

【図6】図5のコンタクトホールの位置と画素欠陥の発生数の関係を示すグラフである。

【図7】実施形態2の構成を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

以下に、図1～図7に基づき、本発明の実施形態を説明する。ただし、これら実施形態は例示に過ぎない。

【0009】

図1は本実施形態にかかる表示装置の構成を示すものであり、(a)は全体構成を示す断面模式図、(b)は全体構成を示す平面模式図、(c)は表示部の画素回路を示す回路図である。

【0010】

図1に示すように、本実施形態にかかる液晶表示装置10は、バックライト2と、アクティブマトリクス基板3、液晶層4およびカラーフィルタ基板5を含む液晶パネル6と、光学フィルム7とを備える。

【0011】

アクティブマトリクス基板3の表示部3pには、画素電極30、トランジスタTR、データ信号線SLおよび走査信号線GLが含まれ、画素回路3gでは、画素電極30は、トランジスタTRを介してデータ信号線SLおよび走査信号線GLに接続される。アクティブマトリクス基板3は、画素電極30と対向する共通電極（図示しない）を含むFFS（Fringe-Field Switching）方式であり、この共通電極を用いてインセルタッチセンサが構成されている。

【0012】

アクティブマトリクス基板3の非表示部（非アクティブ部）3qには、走査信号線GLを駆動するゲートドライバ（駆動回路）GDと、データ信号線SLを駆動するソースドライバを含むICチップTpとが設けられる。なお、ゲートドライバGDおよび画素回路3gは同一基板3sにモノリシックに形成されていてもよい。

【0013】

図2は実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す平面図であり、図3は実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す断面図である。

【0014】

アクティブマトリクス基板3は、行方向に隣り合う2つのサブ画素の一方に対応する第1半導体膜25aと、他方に対応する第2半導体膜25bと、第1半導体膜25aの一部を行方向のチャネルとするトランジスタTRaと、コンタクトホールCHaを介してトランジスタTRaのドレイン電極DRに接続する画素電極30とを備える。

【0015】

トランジスタTRaはボトムゲート構造であり、そのゲート電極GTは、ガラス基板GK上に、例えばチタン（Ti）及び銅（Cu）の積層膜により形成されている。ゲート電極GTは走査信号線GLの一部である。

【0016】

ゲート絶縁膜24は、ゲート電極GTを覆うように形成されている。ゲート絶縁膜GTは、例えば窒化ケイ素（SiNx）や二酸化ケイ素（SiO₂）からなる。

【0017】

ゲート絶縁膜24の上層には、第1半導体膜25aおよび第2半導体膜25bが形成されている。第1半導体膜25aおよび第2半導体膜25bは、例えば酸化物半導体膜であり、In、Ga及びZnのうち少なくとも1種の金属元素を含んでいてもよい。本実施形態では、第1半導体膜25aおよび第2半導体膜25bは、例えば、In-Ga-Zn-O系の半導体を含む。ここで、In-Ga-Zn-O系の半導体は、In（インジウム）、Ga（ガリウム）、Zn（亜鉛）の三元系酸化物であって、In、Ga及びZnの割合（組成比）は特に限定されず、例えばIn:Ga:Zn=2:2:1、In:Ga:Zn=1:1:1、In:Ga:Zn=1:1:2等を含む。

【0018】

トランジスタTRaのソース電極SR及びドレイン電極DRは、第1半導体膜25a上に、互いに離間するように、例えばチタン（Ti）及び銅（Cu）の積層膜により形成されている。なお、ソース電極SRはデータ信号線SLの一部である。

【0019】

無機絶縁膜27は、ソース電極SR及びドレイン電極DRを覆うように、例えば窒化ケイ素（SiNx）や二酸化ケイ素（SiO₂）により形成されている。無機絶縁膜27上には、有機絶縁膜である平坦化膜28が、例えばポリメタクリル酸メチル樹脂（PMMA）等のアクリル系樹脂材料により形成される。

【0020】

平坦化膜28上には、無機絶縁膜29を介して画素電極30が形成されている。また、

画素電極30上には、無機絶縁膜31を介して共通電極32が形成されている。画素電極30および共通電極32は透明電極であって、例えばITO (Indium Tin Oxide)、ZnO (Zinc Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide)、ITZO (Indium Tin Zinc Oxide)等の材料からなる。

【0021】

無機絶縁膜27、平坦化膜28および無機絶縁膜29によって層間絶縁膜SZが構成され、層間絶縁膜SZを貫通する2つのコンタクトホールCHa・CHbによってドレイン電極DRと画素電極30とが接続されている。

【0022】

〔実施形態1〕

図2は、実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す平面図である。図3は、実施形態1にかかる表示パネルの構成を示す断面図である。なお、図2、図3は、5型のフルHD液晶パネル（画素密度が441ppi）を示している。

【0023】

実施形態1では、平面視における、トランジスタTRaのチャネルCNのドレイン電極側エッジCeからコンタクトホールCHaの底面BFに到るまでの行方向（図中X方向）の距離dcを、行方向のサブ画素ピッチdp（例えば、 $19.2\mu\text{m}$ ）の0.154倍（例えば、 $2.96\mu\text{m}$ ）以上とする。図2・図3では、より好ましい構成として、0.234倍（例えば、 $dc=4.49\mu\text{m}$ ）としている。

【0024】

層間絶縁膜SZを貫通するコンタクトホールCHaは、底側（ガラス基板側）に向けて先細となる（開口面よりも底面が小さい）順テーパ形状である。距離dcは、層間絶縁膜SZの厚み（例えば、 $2.8\mu\text{m}$ ）の1.2倍以上であり、図2・図3では、より好ましい構成として、1.6倍としている。

【0025】

第1半導体膜25aの行方向の長さは、画素ピッチの0.45倍以上とする。図2・図3では、より好ましい構成として、0.55倍（例えば、 $10.6\mu\text{m}$ ）としている。また、第1および第2半導体膜25a・25bが、サブ画素ピッチdpの0.48倍未満の間隙をおいて行方向に並んでいる。図2・図3では、より好ましい構成として、0.45倍（例えば、 $8.6\mu\text{m}$ ）としている。

【0026】

コンタクトホールCHaの底面BFの行方向の幅は、サブ画素ピッチdpの0.21倍以上である。図2・図3では、より好ましい構成として、0.24倍（例えば、 $4.6\mu\text{m}$ ）としている。

【0027】

第2半導体膜25bとコンタクトホールCHaの底面BFとの行方向の間隙dtが、サブ画素ピッチdpの0.19倍未満である。図2・図3では、より好ましい構成として、0.18倍（例えば、 $3.5\mu\text{m}$ ）としている。

【0028】

ドレイン電極DRの行方向の幅は、サブ画素ピッチdpの0.38倍以上である。図2・図3では、より好ましい構成として、0.42倍（例えば、 $8.1\mu\text{m}$ ）としている。

【0029】

画素電極の行方向の幅が、サブ画素ピッチdpの0.68倍以上である。図2・図3では、より好ましい構成として、0.72倍（例えば、 $13.8\mu\text{m}$ ）としている。

【0030】

データ信号線SLの幅が画素ピッチdpの0.16倍以上である。図2・図3では、より好ましい構成として、0.19倍（例えば、 $3.6\mu\text{m}$ ）としている。

【0031】

コンタクトホールCHaの底面BFの一部Cg（第2半導体膜25b側のY方向に沿う端部）がドレイン電極DRと重ならない。

【0032】

図4は、実施形態1にかかる画素電極および共通電極の構成を示す平面図である。図4に示すように、画素電極30および共通電極32は無機絶縁膜31を介して対向し、共通電極32にはスリット32sが形成されている（FFS方式）。

【0033】

図5はコンタクトホール10の位置（底面の位置）を示す断面図であり、図6は、図5のコンタクトホール10の位置と画素欠陥の発生数の関係を示すグラフである。図5(a)・図6に示すように、高精細化のためにトランジスタとコンタクトホールとの距離を縮めると画素欠陥が増えることがわかる。そして、 $d_p = 2.75 \mu\text{m}$ では画素欠陥の発生数が高いが、 $d_p = 2.96 \mu\text{m}$ では画素欠陥の発生数がかなり低下し、図5(b)のように $d_p = 4.5 \mu\text{m}$ とすると、発生数がほぼ0になることがわかる。すなわち、アクティブマトリクス基板3を図2および図3のように構成することで、画素欠陥の発生を抑えながら高精細化が可能となる。

【0034】

〔実施形態2〕

実施形態2のアクティブマトリクス基板は、画素毎にTF T（画素用TF T）を備えている。画素用TF Tとしては、例えばIn-Ga-Zn-O系の半導体膜を活性層とする酸化物半導体TF Tが用いられる。

【0035】

画素用TF Tと同一基板上に、周辺駆動回路の一部または全体を一体的に形成することもある。このようなアクティブマトリクス基板は、ドライバモノリシックのアクティブマトリクス基板と呼ばれる。ドライバモノリシックのアクティブマトリクス基板では、周辺駆動回路は、複数の画素を含む領域（表示領域）以外の領域（非表示領域または額縁領域）に設けられる。周辺駆動回路を構成するTF T（回路用TF T）は、例えば、多結晶シリコン膜を活性層とした結晶質シリコンTF Tが用いられる。このように、画素用TF Tとして酸化物半導体TF Tを用い、回路用TF Tとして結晶質シリコンTF Tを用いると、表示領域では消費電力を低くすることが可能となり、さらに、額縁領域を小さくすることが可能となる。

【0036】

図7は、実施形態2のアクティブマトリクス基板の構成を示す断面図である。図7に示すように、アクティブマトリクス基板300において、駆動回路形成領域101には回路用TF Tとして薄膜トランジスタ10Aが形成され、表示領域102の各画素には画素用TF Tとして薄膜トランジスタ10Bが形成されている。

【0037】

アクティブマトリクス基板300は、基板11と、基板11の表面に形成された下地膜12と、下地膜12上に形成された薄膜トランジスタ10Aと、下地膜12上に形成された薄膜トランジスタ10Bとを備えている。薄膜トランジスタ10Aは、結晶質シリコンを主として含む活性領域を有している。薄膜トランジスタ10Bは、酸化物半導体を主として含む活性領域を有している。

【0038】

薄膜トランジスタ10Aおよび薄膜トランジスタ10Bは、基板11に一体的に作り込まれている。ここでいう「活性領域」とは、TF Tの活性層となる半導体層のうちチャネルが形成される領域を指すものとする。

【0039】

薄膜トランジスタ10Aは、下地膜12上に形成された結晶質シリコン半導体層（例えば低温ポリシリコン層）13と、結晶質シリコン半導体層13を覆う第1の絶縁層14と、第1の絶縁層14上に設けられたゲート電極15Aとを有している。第1の絶縁層14のうち結晶質シリコン半導体層13とゲート電極15Aとの間に位置する部分は、薄膜トランジスタ10Aのゲート絶縁膜として機能する。結晶質シリコン半導体層13は、チャネルが形成される領域（活性領域）13cと、活性領域の両側にそれぞれ位置するソース

領域13sおよびドレイン領域13dとを有している。

【0040】

この例では、結晶質シリコン半導体層13のうち、第1の絶縁層14を介してゲート電極15Aと重なる部分が活性領域13cとなる。薄膜トランジスタ10Aは、また、ソース領域13sおよびドレイン領域13dにそれぞれ接続されたソース電極18sAおよびドレイン電極18dAを有している。ソースおよびドレイン電極18sA、18dAは、ゲート電極15Aおよび結晶質シリコン半導体層13を覆う絶縁膜（ここでは、第2の絶縁層16）上に設けられ、絶縁膜に形成されたコンタクトホール内で結晶質シリコン半導体層13と接続されている。

【0041】

薄膜トランジスタ10Bは、下地膜12上に設けられたゲート電極15Bと、ゲート電極15Bを覆う第2の絶縁層16と、第2の絶縁層16上に配置された酸化物半導体層17（第1半導体膜）とを有している。

【0042】

図7に示すように、薄膜トランジスタ10Aのゲート絶縁膜である第1の絶縁層14が、薄膜トランジスタ10Bを形成しようとする領域まで延設されている。この場合には、酸化物半導体層17は、第1の絶縁層14上に形成されている。第2の絶縁層16のうちゲート電極15Bと酸化物半導体層17との間に位置する部分は、薄膜トランジスタ10Bのゲート絶縁膜として機能する。

【0043】

酸化物半導体層17は、チャンネルが形成される領域（活性領域）17cと、活性領域の両側にそれぞれ位置するソースコンタクト領域17sおよびドレインコンタクト領域17dとを有している。この例では、酸化物半導体層17のうち、第2の絶縁層16を介してゲート電極15Bと重なる部分が活性領域17cとなる。また、薄膜トランジスタ10Bは、ソースコンタクト領域17sおよびドレインコンタクト領域17dにそれぞれ接続されたソース電極18sBおよびドレイン電極18dBをさらに有している。なお、基板11上に下地膜12を設けない構成も可能である。

【0044】

これらの薄膜トランジスタ10A、10Bは、パッシベーション膜19および平坦化膜20で覆われている。画素用TFTとして機能する薄膜トランジスタ10Bでは、ゲート電極15Bはゲートバスライン（図示せず）、ソース電極18sBはソースバスライン（図示せず）、ドレイン電極18dBは画素電極23に接続されている。この例では、ドレイン電極18dBは、パッシベーション膜19および平坦化膜20に形成されたコンタクトホールCH内で、対応する画素電極23と接続されている。ソース電極18sBにはソースバスラインを介してビデオ信号が供給され、ゲートバスラインからのゲート信号に基づいて画素電極23に必要な電荷が書き込まれる。

【0045】

実施形態2でも、平面視における、トランジスタ10Bのチャンネルのドレイン電極側エッジCeからコンタクトホールCHの底面に到るまでの行方向（図中横方向）の距離dcを、行方向のサブ画素ピッチの0.154倍以上、より好ましくは、0.234倍とする。

【0046】

なお、図示するように、平坦化膜20上にコモン電極として透明導電層21が形成され、透明導電層（コモン電極）21と画素電極23との間に第3の絶縁層22が形成されている。この場合、画素電極23にスリット状の開口が設けられている。このようなアクティブマトリクス基板300は、例えばFFS（Fringe Field Switching）モードの表示装置に適用され得る。FFSモードは、一方の基板に一对の電極を設けて、液晶分子に、基板面に平行な方向（横方向）に電界を印加する横方向電界方式のモードである。

【0047】

この例では、画素電極23から出て液晶層（図示せず）を通り、さらに画素電極23のスリット状の開口を通してコモン電極21に出る電気力線で表される電界が生成される。この電界は、液晶層に対して横方向の成分を有している。その結果、横方向の電界を液晶層に印加することができる。横方向電界方式では、基板から液晶分子が立ち上がらないため、縦方向電界方式よりも広視野角を実現できるという利点がある。

【0048】

図示する例では、薄膜トランジスタ10Aは、ゲート電極15Aと基板11（下地膜12）との間に結晶質シリコン半導体層13が配置されたトップゲート構造を有している。一方、薄膜トランジスタ10Bは、酸化物半導体層17と基板11（下地膜12）との間にゲート電極15Bが配置されたボトムゲート構造を有している。このような構造を採用することにより、同一基板11上に、2種類の薄膜トランジスタ10A、10Bを一体的に形成する際に、製造工程数や製造コストの増加をより効果的に抑えることが可能である。

【0049】

薄膜トランジスタ10Aおよび薄膜トランジスタ10BのTFT構造は上記に限定されない。例えば、これらの薄膜トランジスタ10A、10Bが同じTFT構造を有していてもよい。あるいは、薄膜トランジスタ10Aがボトムゲート構造、薄膜トランジスタ10Bがトップゲート構造を有していてもよい。また、ボトムゲート構造の場合、薄膜トランジスタ10Aのようにチャンネルエッチ型でも良いし、エッチストップ型でも良い。また、ソース電極及びドレイン電極が半導体層の下方に位置するボトムコンタクト型でも良い。

【0050】

薄膜トランジスタ10Bのゲート絶縁膜である第2の絶縁層16は、薄膜トランジスタ10Aが形成される領域まで延設され、薄膜トランジスタ10Aのゲート電極15Aおよび結晶質シリコン半導体層13を覆う層間絶縁膜として機能してもよい。このように薄膜トランジスタ10Aの層間絶縁膜と薄膜トランジスタ10Bのゲート絶縁膜とが同一の層（第2の絶縁層）16内に形成されている場合、第2の絶縁層16は積層構造を有していてもよい。

【0051】

薄膜トランジスタ10Aのゲート電極15Aと、薄膜トランジスタ10Bのゲート電極15Bとは、同一層内に形成されていてもよい。また、薄膜トランジスタ10Aのソースおよびドレイン電極18sA、18dAと、薄膜トランジスタ10Bのソースおよびドレイン電極18sB、18dBとは、同一の層内に形成されていてもよい。「同一層内に形成されている」とは、同一の膜（導電膜）を用いて形成されていることをいう。これにより、製造工程数および製造コストの増加を抑制できる。

【0052】

実施形態2における酸化物半導体層17は、例えばIn-Ga-Zn-O系の半導体（以下、「In-Ga-Zn-O系半導体」と称する。）を含む。ここで、In-Ga-Zn-O系半導体は、In（インジウム）、Ga（ガリウム）、Zn（亜鉛）の三元系酸化物であって、In、GaおよびZnの割合（組成比）は特に限定されず、例えばIn:Ga:Zn=2:2:1、In:Ga:Zn=1:1:1、In:Ga:Zn=1:1:2等を含む。

【0053】

In-Ga-Zn-O系の半導体は、アモルファスでもよいし、結晶質でもよい。結晶質In-Ga-Zn-O系の半導体としては、c軸が層面に概ね垂直に配向した結晶質In-Ga-Zn-O系の半導体が好ましい。このようなIn-Ga-Zn-O系半導体の結晶構造は、例えば、特開2012-134475号公報に開示されている。参考のために、特開2012-134475号公報の開示内容の全てを本明細書に援用する。

【0054】

酸化物半導体層17は、In-Ga-Zn-O系半導体の代わりに、他の酸化物半導体を含んでいてもよい。例えばZn-O系半導体（ZnO）、In-Zn-O系半導体、Z

n-Ti-O系半導体 (ZTO)、Cd-Ge-O系半導体、Cd-Pb-O系半導体、CdO (酸化カドニウム)、Mg-Zn-O系半導体、In-Sn-Zn-O系半導体 (例えば $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2\text{-ZnO}$)、In-Ga-Sn-O系半導体などを含んでいてもよい。

【0055】

〔まとめ〕

態様1：行方向に隣り合う2つのサブ画素の一方に対応する第1半導体膜と、他方に対応する第2半導体膜と、前記第1半導体膜の一部を行方向のチャンネルとするトランジスタと、コンタクトホールを介して前記トランジスタのドレイン電極に接続する画素電極とを備え、平面視においては、前記チャンネルのドレイン電極側エッジから前記コンタクトホールの底面に到るまでの行方向の距離が、行方向のサブ画素ピッチの0.15倍以上であるアクティブマトリクス基板。

【0056】

態様2：前記距離が、前記サブ画素ピッチの0.23倍以上である例えば態様1記載のアクティブマトリクス基板。

【0057】

態様3：前記コンタクトホールは順テーパ形状であり、層間絶縁膜を貫通する例えば態様1または2記載のアクティブマトリクス基板。

【0058】

態様4：前記距離が、前記層間絶縁膜の厚みの1.2倍以上である例えば態様3に記載のアクティブマトリクス基板。

【0059】

態様5：前記第1半導体膜の行方向の長さが、前記サブ画素ピッチの0.45倍以上である例えば態様1～4のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0060】

態様6：前記第1および第2半導体膜が、前記サブ画素ピッチの0.48倍未満の間隙において行方向に並んでいる例えば態様1～5のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0061】

態様7：前記底面の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの0.21倍以上である例えば態様1～6のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0062】

態様8：前記第2半導体膜と前記底面との行方向の間隙が、前記サブ画素ピッチの0.19倍未満である例えば態様1～7のいずれか1項に記載の表アクティブマトリクス基板。

【0063】

態様9：前記ドレイン電極の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの0.38倍以上である例えば態様1～8のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0064】

態様10：前記画素電極の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの0.68倍以上である例えば態様1～9のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0065】

態様11：前記トランジスタのソース電極にデータ信号線が接続され、前記データ信号線の幅が画素ピッチの0.16倍以上である例えば態様1～10のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0066】

態様12：前記層間絶縁膜は、無機絶縁膜および有機絶縁膜を含む例えば態様1～11のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0067】

態様13：前記コンタクトホールの底面の一部が前記ドレイン電極と重ならない例えば

態様1～12のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0068】

態様14：前記画素電極よりも上層の無機絶縁膜を介して前記画素電極と対向する共通電極を含み、前記画素電極および前記共通電極の少なくとも一方にスリットが形成されている例えば態様1～13のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0069】

態様15：1インチ当たりのサブ画素数が1200以上である例えば態様1～14のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0070】

態様16：前記第1および第2半導体膜は酸化物半導体で構成されている例えば態様1～15のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0071】

態様17：前記第1および第2半導体膜とは異なる材料で構成された第3半導体膜を備える例えば態様1～18のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【0072】

態様18：前記トランジスタおよび前記第3半導体膜をチャンネルとするトランジスタの一方はボトムゲート構造であり、他方はトップゲート構造である例えば態様17に記載のアクティブマトリクス基板。

【0073】

態様19：例えば態様1～18に記載のアクティブマトリクス基板を備える液晶表示装置。

【0074】

本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせ得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。

〔まとめ〕

【符号の説明】

【0075】

3 アクティブマトリクス基板

10 液晶パネル

GL 走査信号線

SL データ信号

DR ドレイン電極

CHa・CHb CH コンタクトホール

dp サブ画素ピッチ

25a 第1半導体膜

25b 第2半導体膜

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

行方向に隣り合う 2 つのサブ画素の一方に対応する第 1 半導体膜と、他方に対応する第 2 半導体膜と、前記第 1 半導体膜の一部を行方向のチャンネルとするトランジスタと、コンタクトホールを介して前記トランジスタのドレイン電極に接続する画素電極とを備え、

平面視においては、前記チャンネルのドレイン電極側エッジから前記コンタクトホールの底面に到るまでの行方向の距離が、行方向のサブ画素ピッチの 0.15 倍以上であるアクティブマトリクス基板。

【請求項 2】

前記距離が、前記サブ画素ピッチの 0.23 倍以上である請求項 1 記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 3】

前記コンタクトホールは順テーパ形状であり、層間絶縁膜を貫通する請求項 1 または 2 記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 4】

前記距離が、前記層間絶縁膜の厚みの 1.2 倍以上である請求項 3 に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 5】

前記第 1 半導体膜の行方向の長さが、前記サブ画素ピッチの 0.45 倍以上である請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 6】

前記第 1 および第 2 半導体膜が、前記サブ画素ピッチの 0.48 倍未満の間隙において行方向に並んでいる請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 7】

前記底面の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの 0.21 倍以上である請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 8】

前記第 2 半導体膜と前記底面との行方向の間隙が、前記サブ画素ピッチの 0.19 倍未満である請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載の表アクティブマトリクス基板。

【請求項 9】

前記ドレイン電極の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの 0.38 倍以上である請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 10】

前記画素電極の行方向の幅が、前記サブ画素ピッチの 0.68 倍以上である請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 11】

前記トランジスタのソース電極にデータ信号線が接続され、
前記データ信号線の幅が画素ピッチの 0.16 倍以上である請求項 1～10 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 12】

前記層間絶縁膜は、無機絶縁膜および有機絶縁膜を含む請求項 1～11 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 13】

前記コンタクトホールの底面の一部が前記ドレイン電極と重ならない請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 14】

前記画素電極よりも上層の無機絶縁膜を介して前記画素電極と対向する共通電極を含み、前記画素電極および前記共通電極の少なくとも一方にスリットが形成されている請求項 1～13 のいずれか 1 項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項 15】

1 インチ当たりのサブ画素数が1200以上である請求項1～14のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項16】

前記第1および第2半導体膜は酸化物半導体で構成されている請求項1～15のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項17】

前記第1および第2半導体膜とは異なる材料で構成された第3半導体膜を備える請求項1～16のいずれか1項に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項18】

前記トランジスタおよび前記第3半導体膜をチャンネルとするトランジスタの一方はボトムゲート構造であり、他方はトップゲート構造である請求項17に記載のアクティブマトリクス基板。

【請求項19】

請求項1～18に記載のアクティブマトリクス基板を備える液晶表示装置。

【書類名】要約書

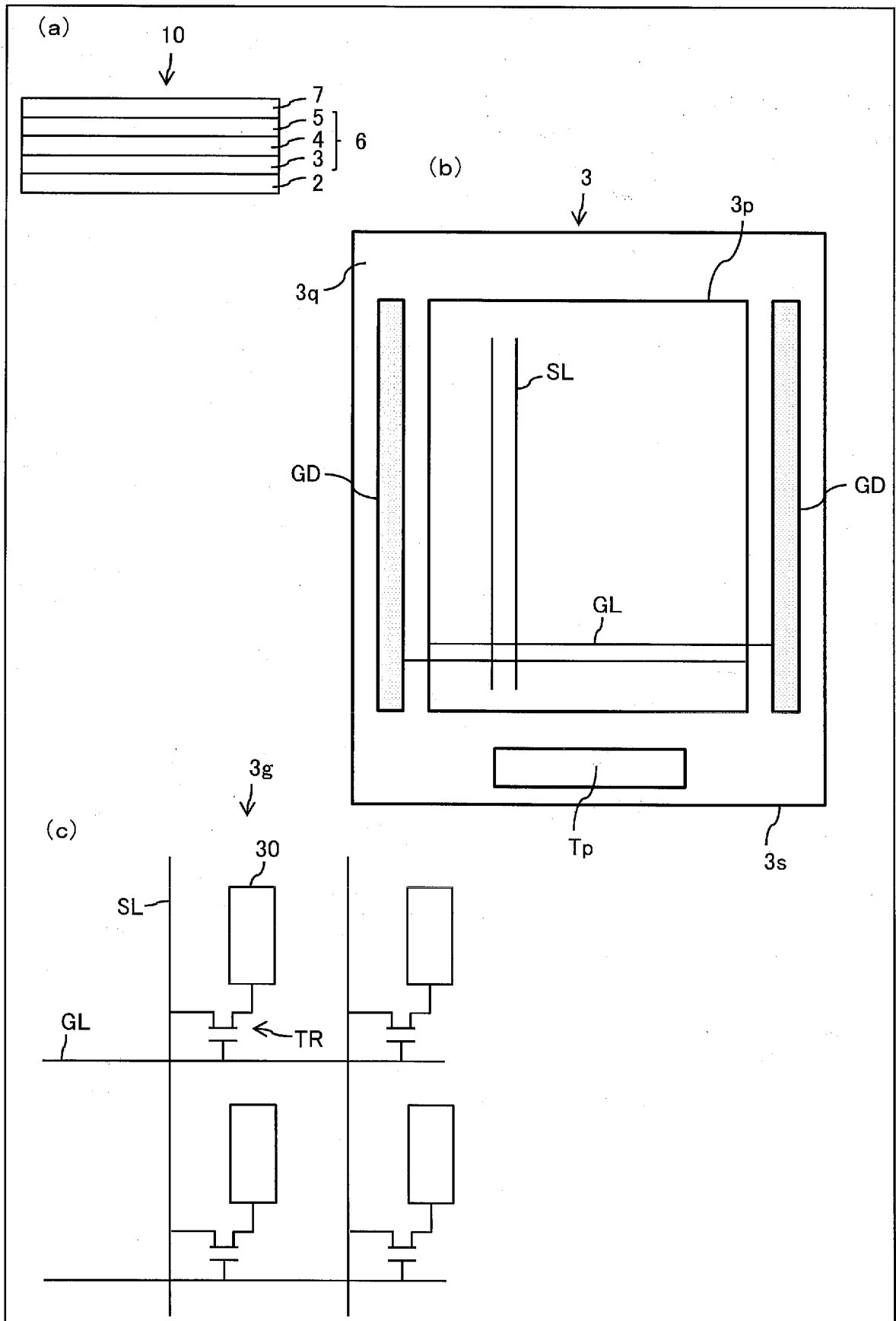
【要約】

【課題】画素欠陥の発生を抑えつつ、高精細なアクティブマトリクス基板を提供する。

【解決手段】行方向に隣り合う2つのサブ画素の一方に対応する第1半導体膜と、他方に対応する第2半導体膜と、前記第1半導体膜の一部を行方向のチャンネルとするトランジスタと、コンタクトホールを介して前記トランジスタのドレイン電極に接続する画素電極とを備え、平面視においては、前記チャンネルのドレイン電極側エッジから前記コンタクトホールの底面に到るまでの行方向の距離（ d_c ）が、行方向のサブ画素ピッチ（ d_p ）の0.15倍以上である。

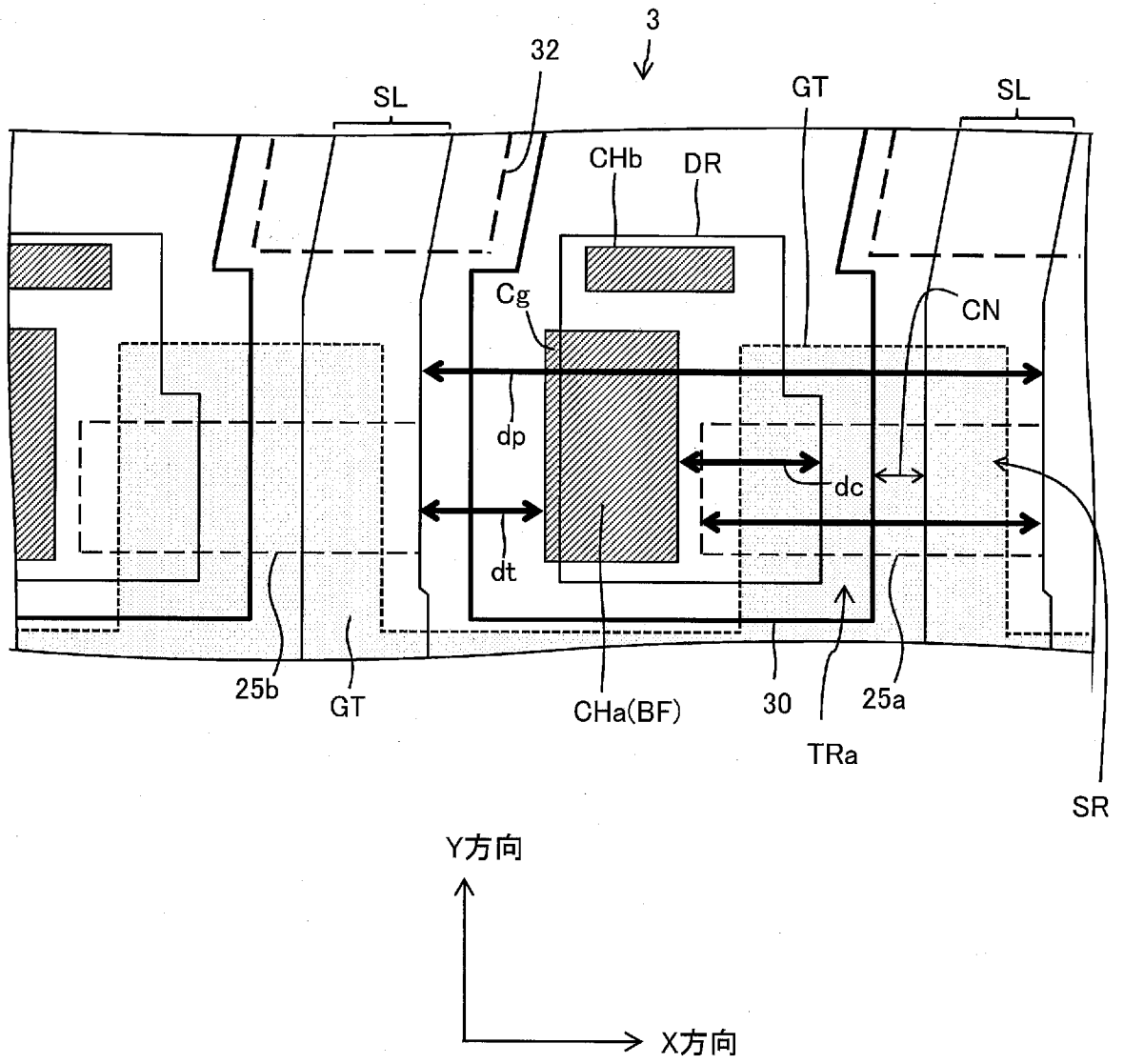
【選択図】図2

図 1



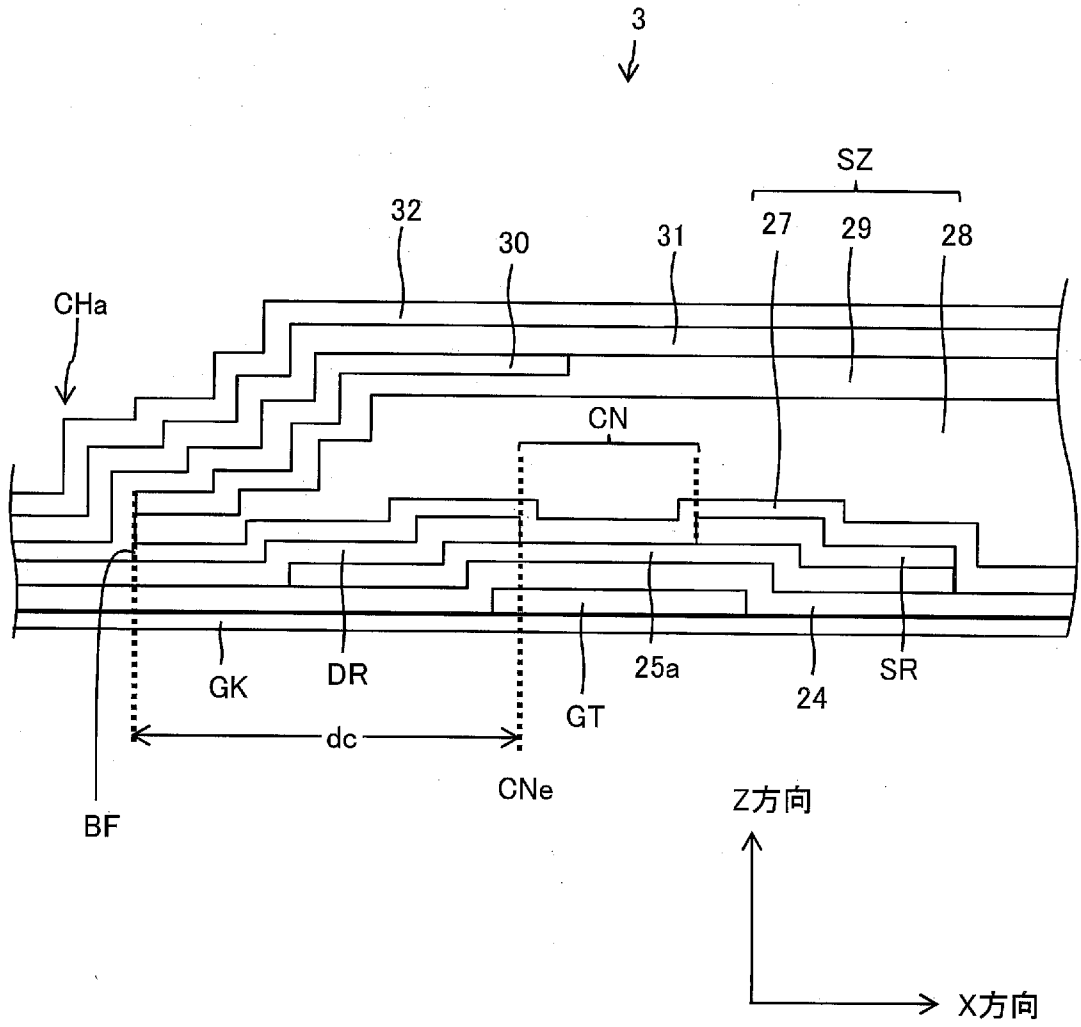
【図2】

図 2



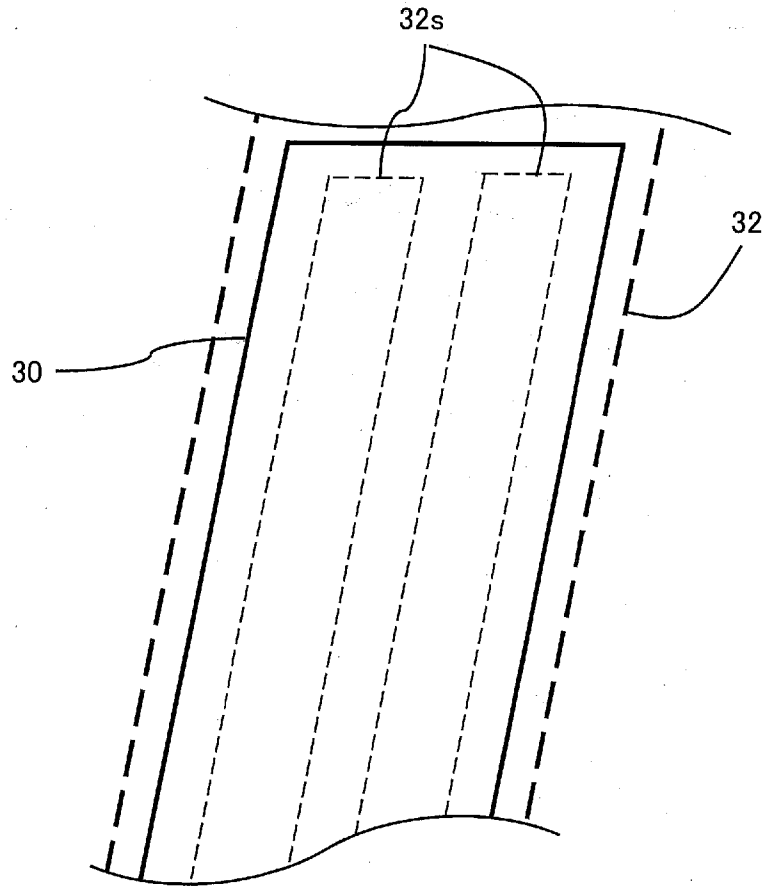
【图3】

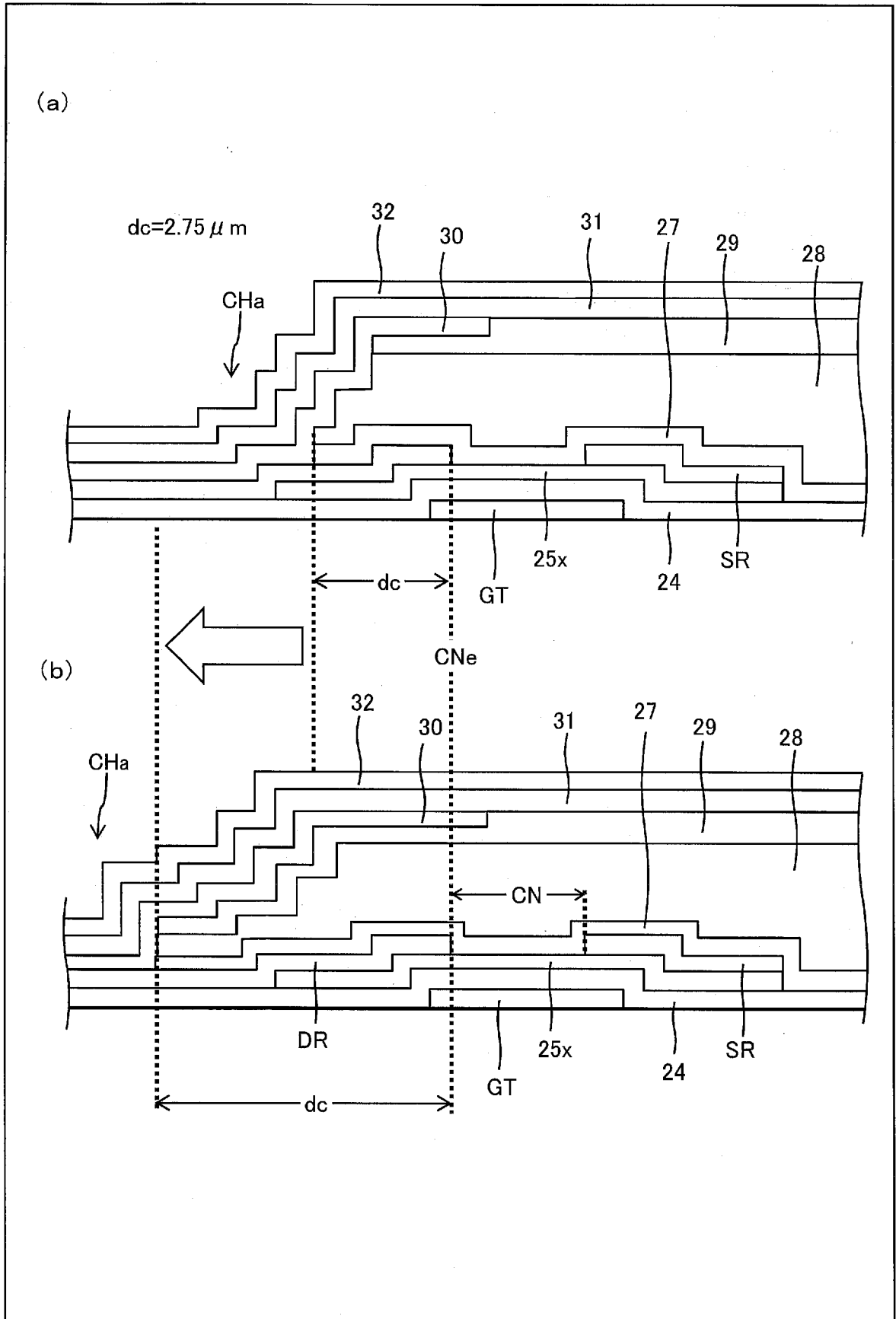
图 3



【图4】

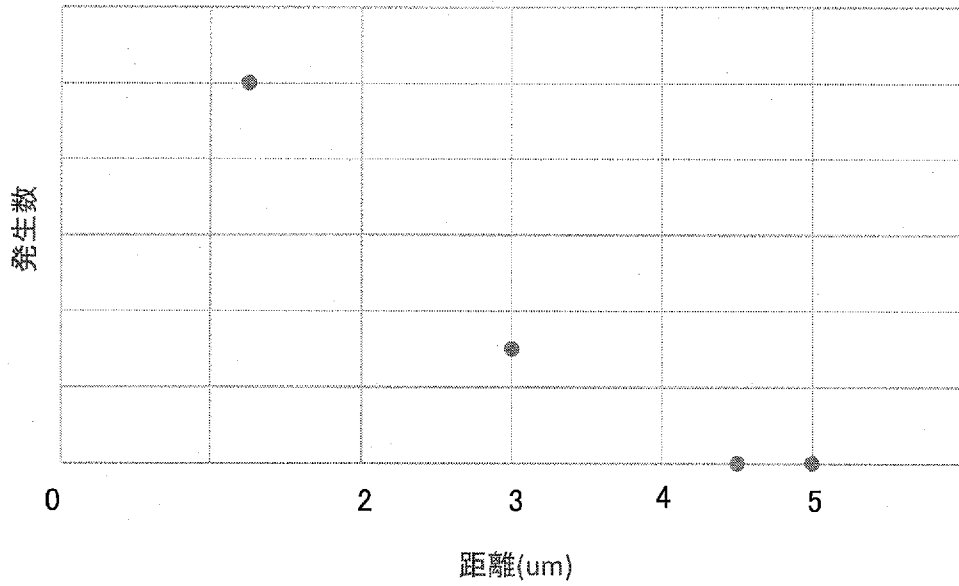
图 4





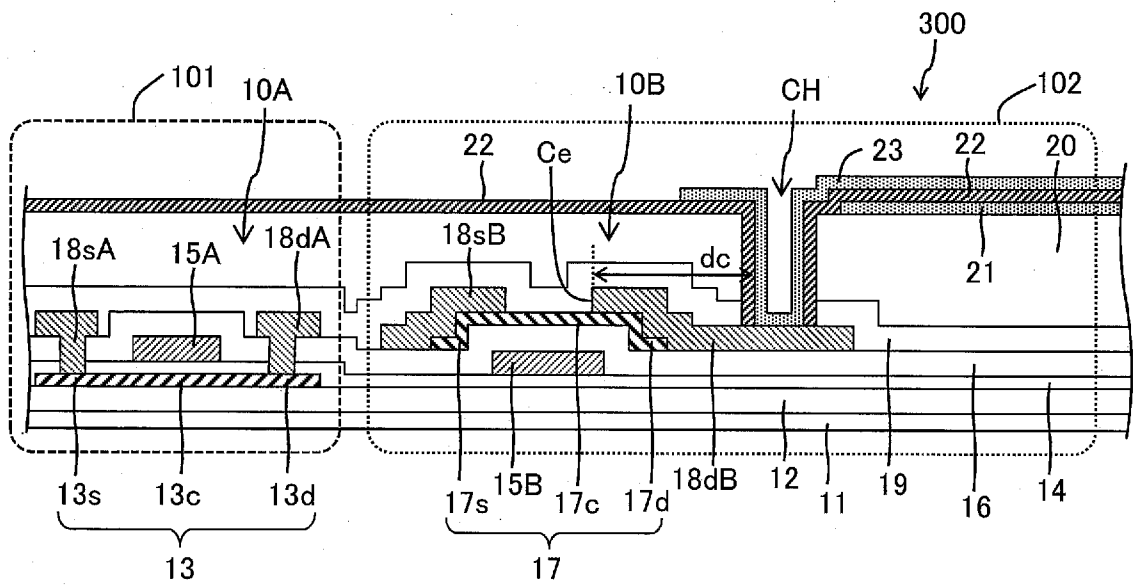
【図6】

図6



【図7】

図7



出願人履歴

000005049

20160701

住所変更

大阪府堺市堺区匠町1番地

シャープ株式会社